

Revision history

Revision	Release data	Description
0.1	2013-11-08	Initial draft
0.2	2013-11-18	Modify Application Figure

Hopengine Confidential

概述

HE2132是一款高精度原边反馈的LED恒流驱动芯片，适用于85Vac~265Vac全范围输入电压、功率5W以下的反激式隔离LED恒流电源

HE2132内置了高精度的采样、补偿电路，使得电路能够达到 $\pm 3\%$ 以内的恒流精度，具有优异的线型调整率和负载调整率，并且通过RADJ引脚外界电阻可以方便地控制LED开路保护电压

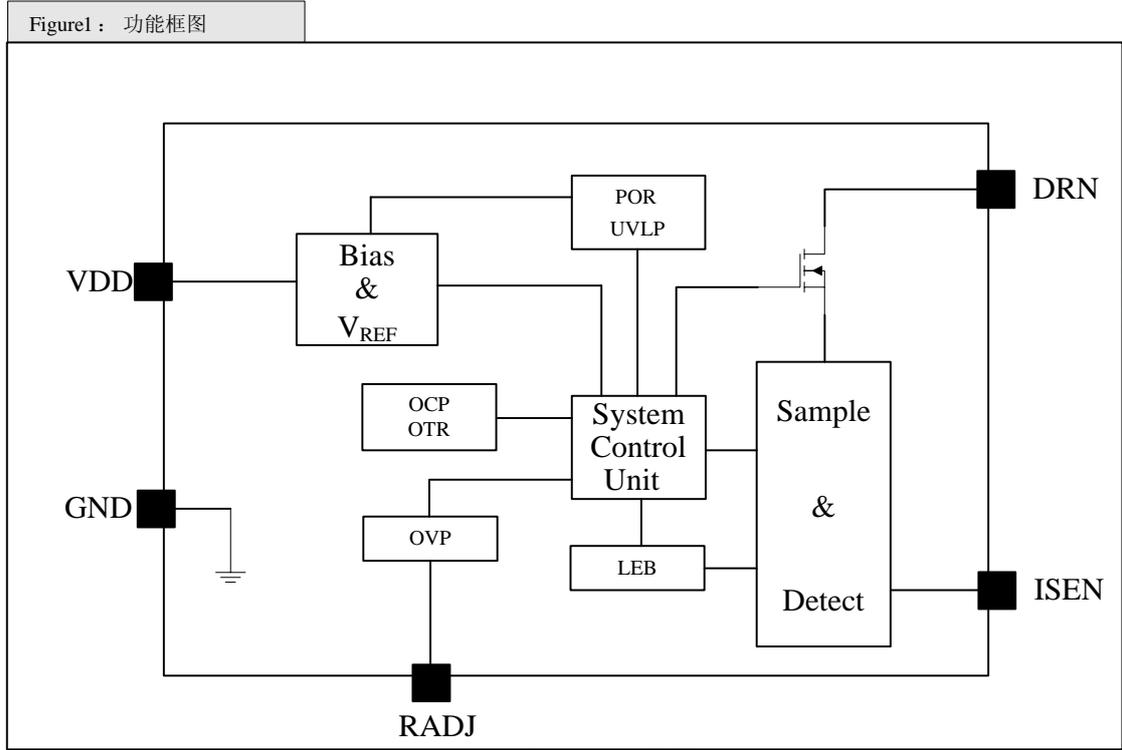
HE2132内部集成了650V功率MOSFET，采用双绕组原边反馈模式，无需次级反馈电路，也无需补偿电路，加之精准稳定的自适应技术，使得系统外围结构十分简单，可在外围器件数量少，参数范围宽松的条件下实现高精度恒流控制，极大地节约了系统成本和体积，并且能够确保在批量生产时LED灯具参数的一致性

HE2132具有丰富的保护功能：输出开短路保护、采样电阻开短路保护、欠压保护、输出过压保护、过温自适应调节等

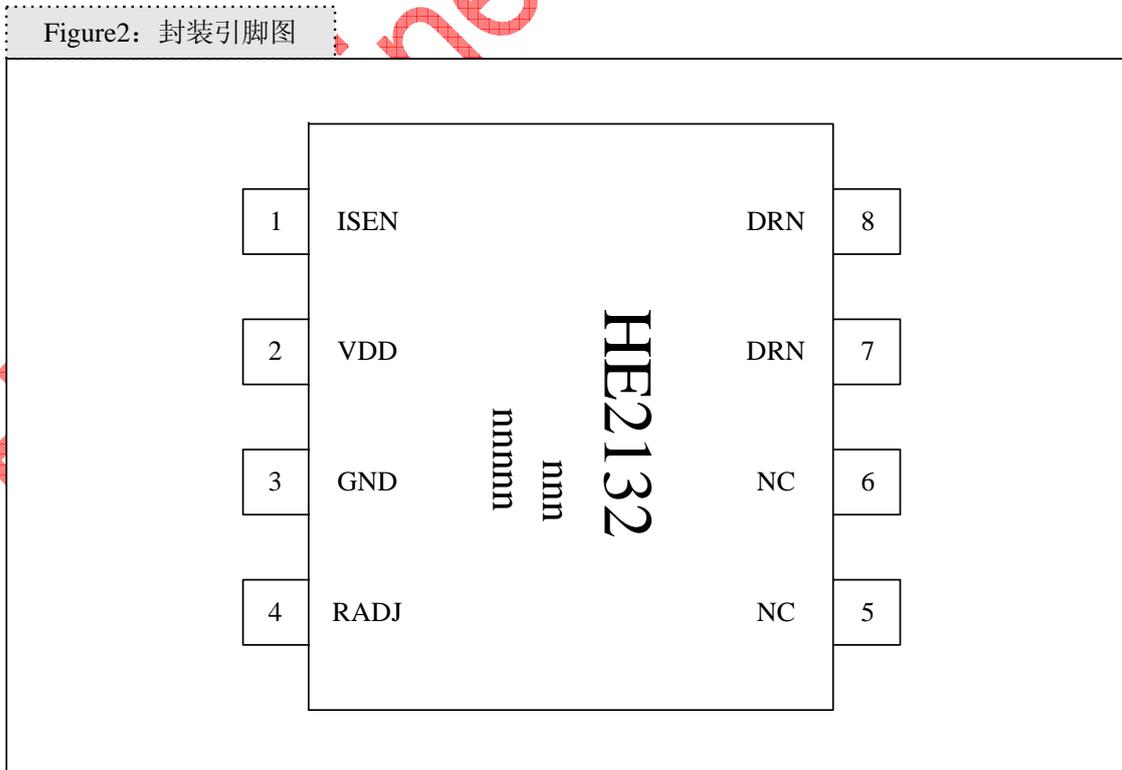
特性

- 内部集成 650V 功率管
- $\pm 3\%$ 以内的系统恒流精度
- 原边反馈恒流控制，无需次级反馈电路
- 无需变压器辅助绕组检测和供电，实现双绕组结构
- LED 开路电压可通过外部电阻调整
- 芯片超低工作电流
- 宽输入电压
- 输出开短路保护
- 采样电阻开短路保护
- 输出过压保护
- 芯片供电欠压保护
- 过热自适应调节功能
- 简洁的系统拓补，外围器件极少

功能框图



引脚图



引脚说明

Table 1: 引脚说明

引脚号	符号	功能
1	ISEN	电流采样，外接电阻
2	VDD	工作电源
3	GND	电源地
4	RADJ	设置开路保护，外接电阻
5	NC	空脚
6	NC	空脚
7	DRN	功率 MOSFET 的漏端
8	DRN	功率 MOSFET 的漏端

功能说明

HE2132 是一款专用于 LED 照明的恒流驱动芯片，芯片内部集成 650V 高压 MOSFET，工作在 DCM 模式，适合全电压范围工作，具有良好的线性调整率、负载调整率以及优异的恒流特性，只需很少的外围元器件就能实现，低成本高效率的 LED 恒流控制器

HE2132 采用了双绕组原边反馈技术，无需光耦及 TL431 反馈，也无需辅助绕组供电和检测，系统实现成本极低。

启动

HE2132 启动电流很低，当系统上电后，启动电阻对 V_{DD} 电容进行充电，当 V_{DD} 达到开启阈值时，电路即开始工作。HE2132 的启动电流低至 50 μA 左右，并且内部具有独特的供电机制，因此无需辅助绕组供电

采样电阻与恒流控制

HE2132 是工作在 DCM 模式中，其内部具有一个 400mV 的基准电压，这个基准电压与系统中变压器原边峰值电流进行比较计算，通过采样电阻的调节来实现 LED 驱动电流的大小：

$$I_{LED} = \frac{400}{4R_{ISEN}} \times \frac{N_P}{N_S} mA;$$

其中：I_{LED} 是 LED 的驱动电流，R_{ISEN} 是采样电阻，N_P 是变压器原边绕组匝数，N_S 是变压器副边绕组匝数

系统工作频率

HE2132 系统工作在 DCM 模式，无需环路补偿，最大占空比为 45%。为保证系统工作的稳定性，芯片内部限制了系统最小工作频率，同时芯片最大工作频率推荐不大于 120KHz。系统工作频率的计算公式为：

$$f = \frac{N_P^2 \times V_{LED}}{8 \times N_S^2 \times L_P \times I_{LED}}$$

其中： L_P 是变压器主级侧电感。

开路电压保护电阻设置

在系统设计中，开路电压可以通过变压器匝比来设计确定，但是由于负载要求的多样性，不同的开路保护电压要求给变压器的设计带来了不便。HE2132通过RADJ引脚外接调节电阻，可以在设计合理的变压器的条件下，通过调整RADJ引脚外接电阻阻值来调节系统开路保护电压，而无需更改变压器，这样大大方便了用户的系统设计，也方便了生产运营，使得用户获得更优的效率和效益

在系统中，当LED开路时，由于无负载连接，输出电压会逐渐上升，进而导致退磁时间也会逐渐变短，因此通过RADJ外接电阻来控制相应的退磁时间，就能得到需要的开路保护电压。根据内部电路计算，可得出 R_{ADJ} 与 V_{OVP} 的关系公式：

$$R_{ADJ} \approx \frac{V_{ISEN} \times L_P \times 16}{R_{ISEN} \times N_{PS} \times V_{OVP}} \times 10^6 (Kohm)$$

其中，

V_{ISEN} 是 ISEN 关断阈值（400mV）

L_P 是原边电感量

R_{ISEN} 是采样电阻

N_{PS} 是变压器的原副边匝比

V_{OVP} 是需要设定的过压保护点

保护功能

HE2132 设定了多种保护功能，如 LED 开短路保护、ISEN 电阻开短路保护、 V_{DD} 过压/欠压、电路过温自适应调节等

HE2132 在工作时，自动监测着各种工作状态，如果负载开路时，则电路将立刻进入过压保护状态，关断内部 MOS 管，同时进入间隔检测状态，当故障恢复后，电路也将自动恢复到正常工作状态；若负载短路，系统将工作在 5KHz 左右的低频状态，功耗很低，同时不断监测系统，若负载恢复正常，则电路也将恢复正常工作；若当 ISEN 电阻短路，或者变压器饱和等其他故障发生，电路内部快速保护机制也将立即停止 MOS 的开关动作，停止运行，此时，电路工作电源也将下降，当触发 UVLO 电路时，系统将会重启，如此，可以实现保护功能的触发、重启工作机制

若工作过程中，HE2132 监测到电路结温度超过过温调节阈值（155°C）时，电路将进入过温调节控制状态，减小输出电流，以控制输出功率和温升，使得系统能够保持一个稳定的工作温度范围

PCB 设计注意事项

V_{DD} 的旁路电容十分关键，PCB 板 layout 时需要尽量靠近 V_{DD} 及 GND 引脚

变压器线圈的充放电回路要尽量短，母线电容、续流二极管、输出电容等功率环路面积要尽量小，芯片距离功率器件也尽量远，从而减小 EMI 以及保证电路安全稳定工作

电路地线及其他小信号的地线须与采样电阻地线分开布线，尽量缩短与电容的距离

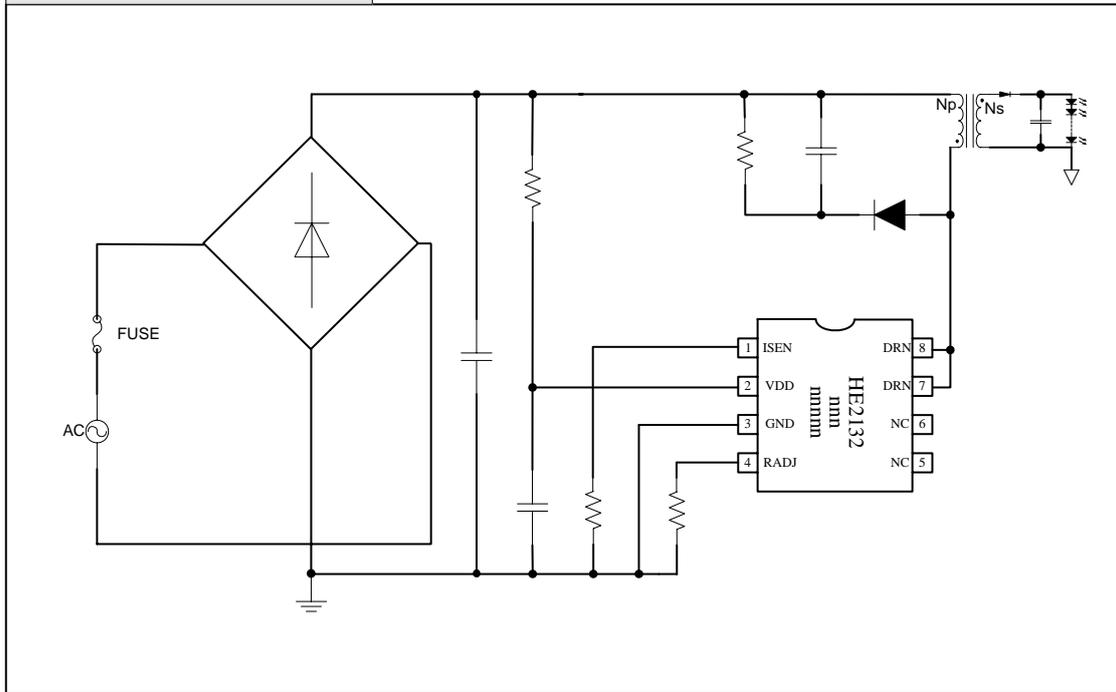
RADJ 外接电阻需要尽量靠近 RADJ 引脚，并且就近接地

NC 引脚建议连接到芯片地（PIN3），有条件时可用地线将 RADJ 电阻环绕

DRN 引脚（PIN7、PIN8）的敷铜面积尽量大，以提高芯片散热

典型应用图

Figure3： 典型应用图



极限参数

Table 2: 极限参数

项目	符号	参数范围	单位
电源电压	V_{DD}	-0.3~20	V
漏极电压	V_{DRN}	-0.3~650	V
电流采样端电压	V_{ISEN}	-0.3~6	V
最大工作电流	I_{DDMAX}	5	mA
开路保护电压调节端	V_{RADJ}	-0.3~6	V
功耗	P_{MAX}	450	mW
结热阻	θ_{JA}	145	$^{\circ}C/W$
工作结温范围	T_J	-40~155	$^{\circ}C$
存储温度范围	T_{STG}	-55~160	$^{\circ}C$
ESD		2000	V

注：超过极限参数范围，本产品的性能及可靠性将得不到保障，实际使用中不得超过极限参数范围

电气特性

Table 3: 电气特性 ($V_{DD}=15V$, $T_{TYP}=25^{\circ}C$)

项目	符号	测试条件	范围	单位
V_{DD} 钳位电压	V_{DD_CLP}	1mA	16.1~17.9	V
工作电流	I_{DD}	$F_{SYS}=70KHz$	≤ 160	μA
启动电压	V_{ST}	V_{DD} 上升	13.5~14.5	V
启动电流	I_{ST}	$V_{DD}=V_{ST}-1V$	≤ 100	μA
欠压保护阈值	V_{UVLO}	V_{DD} 下降	8.5~9.5	V
采样基准电压	V_{ISEN}		390~410	mV
短路时电流检测阈值	V_{ISEN_SHT}	输出短路	200	mV
动作消隐时间	T_{LEB}		500	ns
内部 MOS 关断延迟	T_{DELAY}		200	ns
DRN 端 MOS 漏源极穿电压	$V_{DSS} (BV)$	$V_{GS}=0V / I_{DS}=250\mu A$	650	V
内部 MOS 内阻	R_{SW}	$V_{GS}=15V / I_{DS}=0.5A$	20	Ω
内部 MOS 漏电流	I_{DSS}	$V_{GS}=0V / V_{DS}=650V$	1	μA
R_{ADJ} 引脚电压	V_{RADJ}		0.5	V
系统工作最大占空比	D_{MAX}		45	%
最小工作频率	F_{SYS_MIN}		5	KHz
最大工作频率	F_{SYS_MAX}		120	KHz
过热温度调节点	T_{REG}		155	$^{\circ}C$

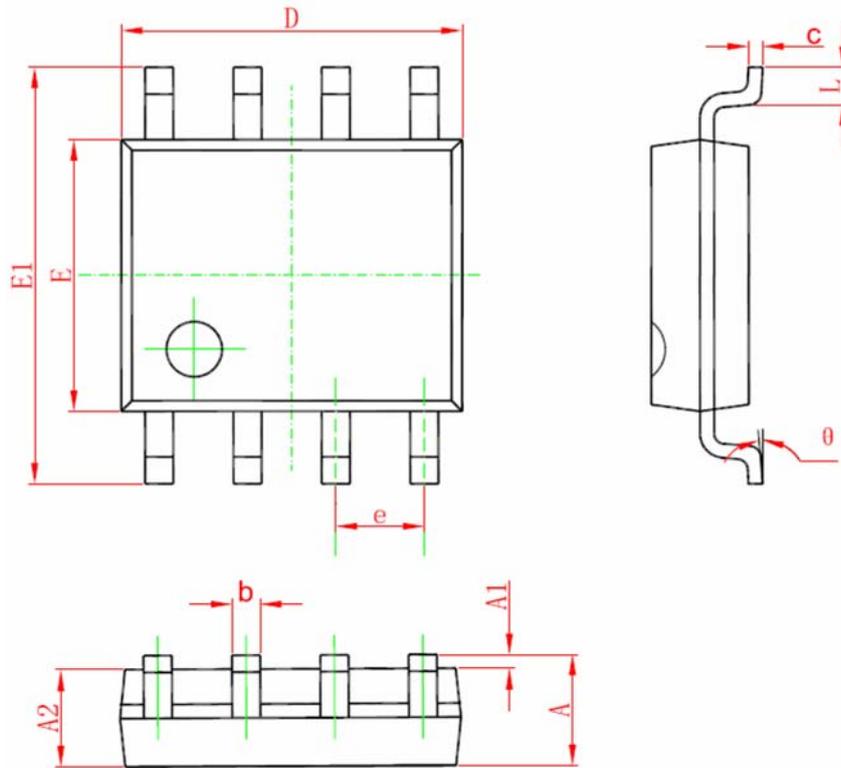
推荐工作范围

Table 4: 推荐工作范围

项目	符号	参数范围	单位
输出功率 (输入电压 $220V \pm 20\%$)	$P_{OUT 1}$	<7	W
输出功率 (输入电压 $85V \sim 265V$)	$P_{OUT 2}$	<5	W
系统工作频率	F_{OP}	<120	KHz

封装形式

SOP8 package outline dimensions



符号	尺寸 (毫米)		尺寸 (英寸)	
	最小	最大	最小	最大
A	1.350	1.750	0.053	0.069
A1	0.100	0.250	0.004	0.010
A2	1.350	1.550	0.053	0.061
b	0.330	0.510	0.013	0.020
c	0.170	0.250	0.006	0.010
D	4.700	5.100	0.185	0.200
E	3.800	4.000	0.150	0.157
E1	5.800	6.200	0.228	0.244
e	1.270(BSC)		0.050(BSC)	
L	0.400	1.270	0.016	0.050
θ	0°		8°	